# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-012142

(43)Date of publication of application: 28.01.1980

(51)Int.CI.

C09K 11/14

C09K 11/20

C09K 11/30

G01T 1/10

// H01S 3/16

(21)Application number : 53-084740

(71)Applicant: DAINIPPON TORYO CO

LTD

**FUJI PHOTO FILM CO** 

LTD

(22)Date of filing:

12.07.1978

(72)Inventor:

**KODERA NOBORU EGUCHI SHUSAKU** 

MIYAHARA JUNJI **MATSUMOTO SEIJI** KATO HISATOYO

# (54) RADIOGRAPHIC IMAGE CONVERSION METHOD

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a practical means for the radiographic image conversion having remarkably improved sensitivity, by the use of a specific accelerated phosphorescent material.

CONSTITUTION: Radiation transmitted through an object is absorbed with (A) Cu and Pb-activated ZnS fluorescent material (ZnS:Cu,Pb), (B) Eu-activated Ba- aluminate fluorescent material (BaO.xAl2O3:Eu) and/or (C) alkaline earth metal silicate fluorescent material MIIO.xSiO2:A, wherein A is Ce, Tb, Eu, Tm, Pb, Tl, Bi, and/or Mn). The fluorescent materials are excited with electromagnetic wave having a wave length of ≥500nm, and the energy stored in the fluorescent material is emitted as fluorescent light. The amount of the activating material in the fluorescent material is pref. 10-6-5×10-3 gram-atom.

### (19) 日本国特許庁 (JP)

### ⑩特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

### 昭55—12142

⑤Int. Cl.³	識別記号	庁内整理番号	<b>⑥公開</b> 昭和	口55年(1980)1月28日
C 09 K 11/1	14	7003—4H		
11/2	20	7003—4H	発明の数	1
11/3	30	7003—4H	審査請求	未請求
G 01 T 1/1	10	2122—2G		
// H 01 S 3/1	16	6655-5F		(全 6 頁)
		•		

### 匈放射線像変換方法

②特 願 昭53-84740

②出 願 昭53(1978) 7 月12日

⑩発 明 者 小寺昇

小田原市中町1-1-1-905

⑫発 明 者 江口周作

小田原市飯泉220-1

70発 明 者 宮原諄二

南足柄市中沼210番地富士写真

フイルム株式会社内

⑫発 明 者 松本誠二

南足柄市中沼210番地富士写真 フイルム株式会社内

@発 明 者 加藤久豊

南足柄市中沼210番地富士写真

フイルム株式会社内

切出 願 人 大日本塗料株式会社

大阪市此花区西九条六丁目1番

124号

⑪出 願 人 富士写真フイルム株式会社

南足柄市中沼210番地

個代 理 人 弁理士 柳田征史 外1名

明 細 鸖

1 発明の名称 放射線像変換方法

2 特許請求の範囲

(1) 被写体を透過した放射線を、(a) 銅及び鉛付活硫化亜鉛螢光体 (2 n S: C n , P b)、

(6) 一般式: $BaO \cdot zAL_2O_3$ :Ez (但し0.8  $\leq$   $z \leq 10$ ) で表わされるユーロピウム付活  $C_2 \cdot C_3 \cdot C_3 \cdot C_4$  (但し $C_3 \cdot C_4 \cdot C_4 \cdot C_5 \cdot C_5 \cdot C_5 \cdot C_6 \cdot$ 

Aは C e , T b , E u , T m , P b , T ℓ , B i , M n の内の少なくとも 1 つ、 0 · 5 ≤ x ≤ 2 · 5 ) で表わされるアルカリ土類金属珪酸塩系盤光体から選ばれる少なくとも 1 つの螢光体を 5 0 0 nm 以上の長波長可視光線及び赤外線から選ばれる電磁波で励起して、螢光体が蓄積している放射線エネルギーを螢光として放出せしめ、この螢光を検出することを特徴とする放射線像変換方法。

(2) 前記電磁被の波長が1000 mm 以下で

あることを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載の放射線像変換方法。

- (3) 前記電磁波がレーザー光であることを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2 項記載の放射線像変換方法。
- (4) 前記レーザー光が H e-Ne レーザーであることを特徴とする特許請求の範囲第 3 項記載の放射線像変換方法。

### 3発明の詳細な説明

本発明は放射線像変換方法、さらに詳しく は輝尽性螢光体を利用した放射線像変換方法 に関する。

従来、放射線画像を得るために銀塩を使用した、いわゆる放射線写真が利用されているが、近年、特に地球規模における銀資源の枯渇等の問題から銀塩を使用しないで放射線像を画像化する方法が望まれるようになつた。

Ce,Sm)、ユーロビウムおよびサマリウム付活碗化ストロンチウム螢光体(SrS:Ex,Sm)、ユーロビウムおよびサマリウム付活酸硫化ランタン螢光体(La2O2S:Ex,Sm)、マンガンおよびハロゲン付活硫化亜鉛、カドミウム螢光体〔(Zn,Cd)S:Mn,X、但し、Xはハロゲンである〕等が知られている程度にすぎず、またこれらの螢光体を用いた方法の感度の向上が望まれている。

本発明は被写体を透過した放射線を螢光体 に吸収せしめ、しかる後、この螢光体を可視 特開 昭55- 12142(2)

変換方法は支持体上に熱盤光性盤光体層を形 成したパネルを用い、とのパネルの熱螢光性 螢光体層に 被写体を透過した放射線を吸収さ せて放射線の強弱に対応した放射線エネルギ - を蓄積させ、 しかる後との熱螢光性螢光体 層を加熱することによつて蓄積された放射線 エネルギーを光の信号として取り出し、この 光の強弱によつて画像を得るものである。し かしながらとの方法は蓄積された放射線エネ ルギーを光の信号に変える際に加熱するので、 パネルが耐熱性を有し、熱によつて変形、変 質しないことが絶対的に必要であり、従つて パネルを構成する熱盤光性盤光体層および支 持体の材料等に大きな制約がある。とのよう に螢光体として熱螢光性螢光体を用い、励起 エネルギーとして熱エネルギーを用いる放射 線像変換方法は応用面で大きな難点がある。

一方、励起エネルギーとして可視光線および赤外線から選ばれる電磁波を用いる放射線 像変換方法もまた知られている(米国特許第



光線および赤外線から選ばれる電磁波で励起してこの螢光体が蓄積している放射線エネルギーを螢光として放射せしめ、この螢光を検出する放射線像変換方法において、感度の著しく高い実用的な放射線像変換方法を提供することを目的とするものである。

本発明者等は上記目的を達成するために上記方法に使用可能な整光体を探索してきた。その結果(a) 銅及び鉛付活硫化亜鉛を光体( $2\pi S: C\pi, Pb$ )、(b) 一般式: $BaO \cdot xA \ell_2 O$ 、:  $E\pi$  (但し、 $0.8 \le x \le 10$ ) で表わささ光体 及び(c) 一般式: $M^{II}O \cdot xS_iO_2:A$  (但し、 $M^{II}O \cdot xS_iO_2:A$  (但し、 $M^{II}O \cdot xS_iO_2:A$  (但  $M^{II}O \cdot xS_iO_2:A$  (  $M^{II}O \cdot xS_iO_2:$ 

ける付活剤の含有量は螢光体の母体に対して 0 ~ 0.2 特に 1 0<sup>-6</sup> ~ 5 × 1 0<sup>-3</sup> グラム原子 であることが好ましい。

本発明の放射線像変換方法は被写体を透過した放射線を 2 m S: C m, P b 螢光体、 B a O · z A L 2 O s: E m 螢光体 および M O · z S i O z: A 螢光体に含まれる螢光体の 1 種もしくは 2 種以上である螢光体に吸収せしめ、 しかるる後、 この螢光体を 5 0 0 mm 以上の長波で励起しての登光体が誘動している放射線エネ・検 は この螢光を検出 し と 密光として放出せしめ、 この螢光を検出 することを特徴と

本発明の放射線像変換方法を概略図を用いて具体的に説明する。第1図において、11 は放射線発生装置、12は被写体、13は可 視ないし赤外輝尽性繁光体層を有する放射線 像変換パネル、14は放射線像変換パネルの 放射線潜像を繁光として放射させるための励 起源としての光源、15は放射線像変換パネ

-

体のトラップレベルに蓄積される。すなわち 放射線透過像の蓄積像(一種の潜像)が形成 される。次にこの潜像を光エネルギーで励起 して顕在化する。すなわち500 \*\*\* 以上の 長波長可視光線および赤外線から選ばれる電 磁波を整光体層に照射してトラップ レベルに 蓄積された電子または正孔を追出し、蓄積像 を厳光として放射せしめる。この放射される 螢光の強弱は蓄積された電子または正孔の数、 すなわち放射線像変換パネル 1 3 の 螢光体層 に吸収された放射線エネルギーの強弱に比例 しており、この光信号を例えば光電子増倍管 等の光電変換装置15で電気信号に変換し、 画像再生装置16によつて画像として再生し、 画像表示装置17によつてとの画像を表示す A . .

次に本発明の放射線像変換方法において用いられる放射線像変換パネルおよび蓄積像を僚光として放射せしめるための励起光源について詳しく説明する。

特開 昭55- 12142(3)

ルより放射された登光を検出する光電変換表で、16は15で検出された光電変換を画像として再生する装置、17は再生されたの反射光をカットし、放射線像変せせかり3より放射された光のみを透過されるのの形である。15以降は13からの形で和を何らかの形で画像としてれるものではない。

放射線像変換パネルの構造は第2図ー(a) 化示されるように支持体21とこの支持体21の片面上に形成された螢光体簡22よりなる。この螢光体簡22は ZnS:Cx,Pb 螢光体、BaO・zAL2O3:Ex 螢光体および M<sup>II</sup>O・zSiO2:A 螢光体から選ばれる螢光体の1種もしくは2種以上から形成されている。

なお、放射線像変換パネルは第2図-(b)に

示されるような 2 枚のガラス板等の透明な基板 2 3 , 2 4 間に 螢光体を狭み こんで任意の厚さの 螢光体層 2 2 とし、その 周囲を密封した 快造のものでも良い。

(.

本発明の放射線像変換方法において上述の放射線像変換パネルの螢光体層を励起する光エネルギーの光原としては、500 nm 以上の長波長可視領域および赤外領域の一方または両方にパンドスペクトル分布をもつた光を放射する光源の他に H・-N・ レーザー光 (1064 nm)、 ルビーレーザー光 (694 nm) 等の単一 放 長の光を放射する光源が使用される。 サール で 長の光を放射する場合は高い励起エネルギーを 大き が 出来る。 レーザー光を 用いるのがより 好ましい。

第 3 図は本発明の放射線像変換方法の放射 線像変換パネルの螢光体層に用いられる ZnS: Cn, Pb 螢光体に管電圧 8 0 KVpの X 線

### 第 1 表

<b>登光体</b>	別起可能な波長範囲	好ましい励起波長範囲
ZnS:Cu,Pb	600~1500 nm	600~ 950 nm
$B = O \cdot z A \ell_2 O_3 : E =$	650~1200nm	650~1000 n m
$M^{U}O \cdot xSiO_{2}: A$	500~1100 nm	500~ 700 nm

第4図は2nS:C\*,Pb 磁光体に管電圧 80KVpのX線を照射した後盤光体に管電圧 割し、照射直後から一定時間毎に750 nm および1300 nm の励起光で励起したの時に 放射される螢光質の変化を相対的に示したした のであり、曲線 a が1300 nm で励起合で ある。この第4図から明らかなように1300 nm で励起した場合(曲線 b )より退行性 のなっての起した場合(曲線 b )より退行性 はフェーディング)が大きい。これは赤外

特閉 昭55- 12142(4) を照射した後、波長の異なる光エネルギーを 与えた時放射される螢光の強度変化を示すも の(いわゆる励起スペクトル)であるが、筑 3 図から明らかなように ZnS:C\*,Pb 螢光体 の場合、励起可能な成長範囲は500~ 1500 nm の範囲にあるが750 nm 付近 の励起光を用いるのが、放射される螢光の強 度が強く、本発明の目的である感度向上のた めには良いことがわかる。すなわちZzS: C\*,Pb 螢光体の場合最適励起波長は600 ~950 nm の間にあることが認められる。 本発明の放射線像変換方法に用いられる各盤 光体の有効励起波長を示すと第1表の通りであ るが、これら螢光体はその励起スペクトルが 5 0 0 ~ 1 5 0 0 nm にわたつて2つのバン ドをもち、特にその短波長側の励起バンドの ピーク強度が強い。このことから励起に用い られる光エネルギーは1000 nm 以下であ るのがより好ましい。



で放射される領域のトラップが浅く、退行性 (フェーディング)現象が顕著なためであり、 従つて情報の保存期間が短かく、実用上は余 り好ましくない。例えば画像を得るに際して パネルの螢光体層を赤外線でスキャンニング して励起し、放射される光を電気的に処理す る操作を取り入れることが度々行なわれるが、 **螢光体層の全面スキャンニングにはある程度** の時間がかかるため、同じ放射線量が照射さ れていても始めの読出し値と最後の読出し値 にずれが生じる恐れがある。このような理由 からも本発明の放射線像変換方法に用いる登 光体としてはトラップが探く、より高エネル ギーの光、すなわちできるだけ短波長の光で 効率よく励起されるものがより望ましいが、 上述のごとく、本発明の方法に用いられる各 盤光体は好ましい励起波長範囲が1000 nm 以下の領域にあり、従つてフェーディン グが少なく螢光体層に蓄積された放射線潜像 の蓄積保存能が高いものである。

本発明において、光エネルギーによつて励 起された結果、螢光体層より放出される螢光 を検出することを要するが、この際、放出さ れる萤光と励起光の反射光とを分離すること がS/N比を向上せしめる上で必要である。 ととろで、螢光体層から放出される螢光を受 光する光電変換器は、一般に600 mm 以下 の短波長の光エネルギーに対して感度が高く なるので、螢光体層から放出される螢光は出 来る限り短波長領域にスペクトル分布をもつ たものが望ましい。本発明において用いられ る螢光体はいずれもかかる特性を備えている。 すなわち、本発明において用いられる螢光体 はいずれも500 \*\*\* 以下に主ピークを有す る発光を示すため、励起光との分離が容易で あり、受光器の分光感度ともよく一致するの で、効率良く受光できる結果、受像系の感度 を高めることが可能となる。第5図に本発明 に用いられる螢光体に、管電圧 8 0 KVpのX 線を照射した後、H•-N• レーザー光で励起

特開 昭55一 12142(5) した時の発光スペクトルを一例として示す。 図中、曲線 a は B a O・6 A 4,O, :E w <sup>2 +</sup> の発光ス ベクトルで、そのピークは435 m であり、 曲顔 b は BaO·SiOz:Caの発光スペクトルで そのピークは425 mm である。第2表は本 発明の放射線像変換方法の一例の感度を SrS:Ex,Sm 螢光体を用いた従来公知の方法 の感度と比較して示すものである。第2表に 於て、感度は放射線像変換パネルに管電圧 8 0 KV p の X 線を照射した後、これを H e-Ne レーザー光で励起し、その螢光体層から 放射される螢光を受光器(分光感度S-5の 光電子增倍管)で受光した場合の発光強度で 表わしたものであり、 SャS:Eェ,Sm 螢光体を 用いた従来公知の方法を1とした相対値で示 してある。

第 2 表

Æ	盤 光 体	相対感度
1	SrS:Eu,Sm (10 <sup>-4</sup> )(10 <sup>-4</sup> )	1
2	ZnS:Cn,Pb (10 <sup>-4</sup> ) (10 <sup>-4</sup> )	700
3	B = 0 · A L <sub>2</sub> O <sub>3</sub> : E = (5×10 <sup>-3</sup> )	150
4	B <sub>1</sub> a O · S i O <sub>2</sub> : C a (10 <sup>-4</sup> )	300

上記第2表から明らかなように本発明の放射線像変換方法(ル2~ル4)は従来公知の放射線像変換方法(ル1)よりも著しく高感度である。

以上説明したように本発明は感度の著しく 高い放射線像変換方法を提供するものであり、 従来の放射線写真法にかわる方法としてその 工業的利用価値は非常に大きなものである。

#### 4 図面の簡単な説明

第 1 図は本発明の放射線像変換方法の概略 説明図、

第2図-(a) および(b) は本発明の放射線像変換方法に用いられる放射線像変換パネルの断面図、

第3図は本発明の放射線像変換方法に用いられる 2 m S: C m , P b 螢光体の励起スペクトルを示す グラフ、

第 4 図は本発明の放射線像変換方法に用い られる Z \* S: C \* , P b 螢光体の退行性を示す ク ラフ、

第 5 図は本発明の放射線像変換方法に用い られる螢光体の発光スペクトルを示すグラフ である。

11……放射線発生装置 12……被写体

1 3 ……放射線像変換パネル

1 4 … … 光原 1 5 … … 光電変換装置

16 … … 画像再生装置 17 … … 画像表示装置

1 8 ··· · · フィルター

21……支持体 22……螢光体曆

23,24……透明支持板

特許出願人 大日本館料株式会社 富士写真フィルム株式会社





